十国源光

第15卷 第6期

C-C转移放电泵浦的 XeCl 准分子激光器的电参量特性 邓国扬* 袁达长 王绍英* 谢仿卿 马 军 费瑞安 顾之玉* (中国科学院安徽光机所)

提要:本文报道 O-O 转移放电泵浦的 XeOl 准分子激光器的电参量对激光器工作特性的影响。

Electric parameter performances of a C-C transfer discharge pumped XeCl laser

Deng Guoyang, Yuan Dachang, Wang Shaoying, Xie Fangqing, Ma Jun, Fei Ruian, Gu Zhiyu (Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica, Hefei)

Abstract: The electric effects of a C-C transfer discharge pumped XeCl laser on its working performances are presented.

引

目前,实用化的准分子激光器常采用 UV预电离,C-C转移放电泵浦方式。对于 放电激励的准分子激光器,电参量的变化对 激光器的工作特性有着重要影响。然而,从 现有文献看,对电参量特性方面的研究报道 尚不够深入、系统。本文报道在同时监测放 电电流、电压波形和输出激光能量的基础上, 对C-C转移放电泵浦的XeOI准分子激光器 充电电压、回路电感和电容等电参量特性的 研究结果,试图为这类实用化激光器的研究 设计提供一些参考。

二、实验装置简述

实验裝置的细节已在另一篇论文中报 道^[11]。为叙述方便,图1仍给出激光器的电 激励原理图和等效电路。图中 O_s,O_a 分别为 储能电容和转移放电电容,L为充电电感, UV预电离火花通过网阴极照射放电区域。 分压器并于 A_x B两端测量 C_a 上的电压,阳 极接地端B串入分流器以监测通过激光气 体的放电电流。而等效电路图中的 L_1,L_2 分 别代表回路1(C_s 对 C_a 充电回路)和回路2 (C_a 通过激光气体放电回路)的等效电感,

收稿日期: 1987年1月16日。

^{*} 现在中国希格玛光电有限公司工作。



图 2 激光能量、总效率随充电电压的变化 HCl:Xe=4.8 Torr:50 Torr

 R_1 、 R_2 分别代表回路1和回路2(主要是激 光气体)的等效电阻,后者是时间的函数。激 光器的工作原理和电路方程的解也参见[1]。 最大激光输出(λ =308 nm, E=328.5 mJ) 所对应的各电参量分别为 L_1 =79.1 nH, L_2 =10.3 nH, C_s =200 nF, C_d =54 nF。

三、充电电压的变化

在固定 HCl:Xe=4.8 Torr:50 Torr 配 比下,加缓冲气体 Ne,在3.5 atm 和2.75 atm 两个总气压下改变充电电压 V_0 。从图 2看出,随着 V_0 升高,输出能量增大,当 $P_n=3.5$ atm 时,输出比线性增长更快,说明 在高气压下,提高 Vo 对增大输出是有利的。

我们记录了每次放电的电压波形。图3 给出了不同 V_0 下电压上升时间 t_r (定义为从 电压开始上升至峰值电压的时间)、峰值击穿 电压 U_b 的变化。发现前者随 V_0 的提高而变 短,后者随 V_0 的提高而上升。图4 是两个不 同 V_0 下的放电电压波形。结合图 3、图4 可 以看出,提高充电电压(从而初始储能)使得 转移至 O_d 的能量相应增大,固然能使输出提 高,但在高充电电压下,气体的击穿相角提 前^{CD},使得初始储能转移至 O_d 的效率反而下 降,所以我们得到了如图 2 所示的总效率随 充电电压的提高而下降的曲线。这说明,为 使器件在高 V_0 下高效率地工作,应设法增大 气体的击穿相角。改变配气成分和适当提高 总气压则是实现这一目的的主要手段。



图 3 峰值击穿电压、电压上升时间随充电 电压的变化

HCl:Xe=4.8 Torr:50 Torr, 充 Ne 至 Pa=3.5 atm



图 4 充电电压的变化对 U₂ 波形的影响 HCl:Xe:Ne=0.18%:1.88%:97.94%, P_B=3.5 atm

在高气压下,提高下。对潜大输出是言利的。

四、电感的影响

为考察电感 L1 对激光器输出特性的影 响,我们改变回路结构,即在图1的储能电容 Os和球隙 SG 之间串入电感线圈。通过改变 线圈圈数,实现了 L1 依次增大而其他参量不 变的条件。从放电电压波形看, 增大 L1, 引 起电压上升时间单调地变长。图5给出了不 同电压上升时间 tr (不同 L1 的结果)所对应 的输出能量、峰值击穿场强。可见,输出能量 随电感的变化十分敏感(实验中, L1的变化 范围为 79.1~230 nH)。增大 L1, 输出能量 明显下降,当电感增至一定值(对应的 tr~ 300 ns)时,放电出现不稳,激光接近阈值。前 面指出,靠提高充电电压增加输出,效率反而 下降。 但减小 L1 获得的高能输出直接导致 高的效率。可见, 要获得高能高效率激光输 出,减小 L1 是一个重要途径。虽然实验是按 增大 L1 的方向进行的,但对所得曲线进行合 理外推,不难发现本器件在进一步减小电感 方面的潜力。从所得实验数据估计,其它条 件不变,在该器件基础上(L1=79.1 nH, E= 328.5 mJ), L1 再减小10%, 输出将增加 10%以上。



图5 不同电压上升时间(由于不同电感 L₁) 时激光能量和峰值击穿场强 充电电压 V₀=24 kV, HCI:Xe:Ne=0.25%:2.1%:97.65%, P_H=2.5 atm



图 6 是 L₁ 值分别为 79.1 nH 和 95.4 nH 时,电压及注入功率波形的比较。显然, 稍微改变结构使 L₁ 增大,放电电压波形前沿 变缓,峰值降低;相应注入脉冲的时间滞后, 幅值变小,注入能量由 10 J 减少至 6.7 J。

五、电容Cs、Ca的作用

文献[1]中,根据等效电路方程的解,我 们已得到描述储能电容 *O*。向放电电容 *C*a转移能量和电压这一过程的两个表达式。即能 量转移效率

$$\eta_{E} \equiv \frac{E_{*}}{\frac{1}{2} O_{s} V_{0}^{2}} = \frac{C_{a}/C_{s}}{(1 + C_{a}/C_{s})^{2}} (1 + e^{-\gamma_{1}\pi/\omega})^{2} \quad (1)$$

和电压转移比

$$\eta_{U} = \frac{U_{b}}{V_{0}} = \frac{1}{1 + C_{d}/C_{s}} (1 + e^{-\gamma_{1}\pi/\omega}) \quad (2)$$

式中 $V_0 \neq C_s$ 上的充电电压, E_{**} 是转移至 C_a 的能量, U_b 是激光气体击穿电压, γ_1 是回路1的阻尼因子, ω 是振荡圆频率。以上两 式的推导假定了激光气体的击穿发生在 C_a 达到最高电压的时刻。(1)式表明, η_E 在 $\eta_c \equiv$ $C_a/C_s = 1$ 时达到极值。可见, $C_a = C_s$ 时对能 量转移最有利。不计损耗,可把 C_s 上的能量 100%地转移至 C_a 。而(2)式表明, η_c 愈小对 电压的转移愈有利,不计损耗,当 $\eta_c \rightarrow 0$ 时 $\eta_v \rightarrow 2$,体现了C-C转移电路的升压作用。 显然,升压作用是以减少能量转移效率为代 价的。

实际上.上述 no 的两种极限情形正代表 了 C-C 转移放电型器件两种截然 不同的 工 作方式: (1)no→0,即在长脉冲运行的情形 下,击穿前 C。上的能量只有极小部分转移至 Oa,但 Oa 的升压作用却有助于激光气体的快 速击穿。随之, C。对激光气体直接放电, 供 给能量。因为回路周期 $T_1 \approx 2\pi \sqrt{L_1 O_s}$ 往往 较长,能量沉积和抽取的持续时间也长,这是 获得长脉冲准分子激光的一种手段,参见文 献[2, 3]。(2) η_c →1,即在短脉冲运行的情 形下,激光气体击穿前, C。上的能量几乎全 部转移至 Oa; 气体击穿后, Oa 直接对激光气 体放电,成为能量的主要提供者。因放电周 期 $T_2 \approx 2\pi \sqrt{L_2 O_4}$ 要比 T_1 短得多,能量沉积 和抽取能很快完成,因此,可望获得高能高效 率运转,参见文献[4]。

在 HCl:Xe:Ne=0.25%:2.1%:97.65%, $P_{\pm}=2.5$ atm 的条件下, 测量了 $O_s=200$ nF 及 $O_s=100$ nF 时输出能量随 O_a 的变化, 结 果示于图7。当 O_a 从 21.6 nF 变到54 nF 时,输出一般随 O_a 的增大而增大,这是预期 的结果。因为据理论分析的结论,理想能量 转移效率($\eta_E=1$)发生在 $\eta_0=1$,而实验中 η_0 的变化范围在0.1~0.54之间。由图7(c)、 (d)看到,当 $O_s=100$ nF, $O_a=54$ nF($\eta_0=$ 0.54)时,输出有饱和趋势,我们认为,这时, 回路的升压效应已显示出来。提高充电电 压,饱和将发生在更高的 η_c 值。比较图7(a)、 (c)发现,在同样的 O_a 值下, O_s 減半(储能相 应减半),输出只降低约 23%。这证实,在高 η_c 下工作,激光器的效率更高。

图 8 给出了三个不同 η₀ 值下的 电压 电 流波形。电压波形由 η₀ 唯一确定,当 η₀ 由 大到小,电压上升由慢到快,击穿点提前,击 穿电压提高。电流波形则是 O_s, O_a 较复杂的 函数。当 O_s 相同时, O_a 大则脉冲宽,峰值高。 当 O_a 相同时,脉宽相等, O_s 大则峰值高,说 明脉冲宽度由 O_a 单独决定,脉冲峰值则有赖



图 7 输出激光能量随 C₁、C₂的变化 (a)、(b): C_s=200nF; (c)、(d): C_s=100nF; (a)、(c): V₀=24kV; (b)、(d): V₀=20kV; HCl:Xe:Ne=0.25%:2.1%:97.65%; P_B=2.5 atm



图 8 不同 C₁、C₂时的电压、电流波形 实线:C_s:200 nF, C_d:54 nF(η_c:0.27);虚线:C_s:200 nF, C_d:21.6 nF(η_c:0.11);点线:C_s:100 nF, C_d:54 nF (η_c:0.54); HCl:Xe:Ne=0.25%:2.1%:97.65%; P_度=2.5a tm; V₀=24 kV

于 C_s 和 C_d,这一点和理论结果¹¹¹ 也是一致的。因为对于放电回路,同样通过等效电路分析,可得到放电电流的近似表达式(假定激光等离子电阻为常数 R₂)

$$i_{2} \approx \frac{2U_{b}}{\sqrt{\frac{4L_{2}}{C_{d}} - R_{2}^{2}}} e^{-\frac{R_{2}}{2L_{2}}t} \times \sin \sqrt{\frac{1}{T_{c}} - \frac{R_{2}^{2}}{4L_{2}^{2}}}t \qquad (3)$$

(下转第331页)

. 335 .

$$g_1^* = \frac{1}{2}, \quad g_2^* = 1$$
 (4-5)

对应热焦距满足

 $f = 2d'_2$ (4-6)

2. 从基本公式(8-1)出发,并对腔参数 和归一化模参数作具体物理分析,就可推导 出望远镜腔热稳定的充分必要条件。事实上 (8-12)(a)、(b)为 W_1 有极值的必要条件,而 (3-12)(c)则保证了 W_1 有极值点存在。同 时,使用本文方法,还同时求出了满足热稳条 件的 D_n 、f、 g_1^* 、 g_2^* 的解析表示式,使用这些公 式,不仅可直接对热稳望远镜腔的性质,例如 g^* 参数图上的分布、腔的失调特性等从物理 上进行分析,而且也给热稳腔的设计带来了 方便。

3.本文使用 g'、g* 参数等价腔可正确求 出输出镜 S1 处基模光斑半径 W1,但不能直 接求得全反射镜 S2 处的基模 光斑 半径 W2, 即等价腔的使用是有条件的。通常使用的单 端输出腔的热稳性实质上是指输出激光束对 光腔热扰动的稳定性。可以证明,对两端输 出、二反射镜皆"匹配"的光腔,仅可能由一端

(上接第335页)

而击穿电压可近似表示为

$$U_b \approx \frac{V_0}{1 + \frac{C_d}{C}} (1 + e^{-\gamma_1 \pi/\omega}) \qquad (4)$$

(3)、(4)式确实反映了前述的电流幅值和脉宽随 C_s、C_a的变化规律。

六、结 论

对激光器电参量的研究结果表明:放电 泵浦的 XeOl 准分子激光器中,各电参量 控 制着初始储存的能量向激光气体内沉积的过 程,从而影响到激光器的输出能量和效率。为 得到高能高效激光输出,要求回路电感尽可 获得热稳的激光束。因此,所有腔参数相同, 但输出端不同的两个多元件腔,就输出特性 而言,一般并不相同。不注意到这点就会得 出错误的结论。

4. 由于使用等价腔的分析方法 和变换 技巧,原则上总可以把含有多个透镜(其中有 一个是热透镜)的多元件腔化为只含有一个 热透镜的腔,因此,本文的分析方法和所得结 果不仅对望远镜腔适用,而且可直接推广用 于分析一般多元件腔的热稳问题,即光腔热 稳定的充分必要条件(8-10)式或(8-12)式具 有普遍性意义,在分析具体腔型时,仅需将相 应的 gⁱ、 A、d_i等的表示式代入而已。

参考文献

- 1 Staffen J et al. IEEE J. Quant. Electr., 1972; QE-18(2): 239
- 2 Lortscher J P et al. Opt. and Quant. Electr., 1975: 7(6): 505
- 3 吕百达。光学学报,1987;7(2):105
- 4 Hanna D₄C et al. Opt. Commun., 1981; 37(5): 359
- 5 Weber H. 激光谐振腔, 华中工学院出版社, 1983: 111 ·

能小以增大电压上升速率,从而获得较高的 注入功率;提高充电电压只有在设法增大激 光气体击穿相角的基础上才能收到良好效 果;而储能电容 *O*_s 一旦选定,对于特定器件, *O*_a 有一特定最佳值。理论上应使 ησ=1。实 际上,兼顾到电压转移比,应取 ησ 为小于1 的某最佳值。

参考文献

- 1 王绍英 et al. 光学学报, 1988; 8(2):125
- 2 Mel'chenko S V et al. Sov. J. Quant. Electr., 1984; 4(17): 1009
- Bychkov Yu I et al. Sov. J. Quant. Electr., 1982:
 12(12): 1581
- 4 Miyozaki Kenzo et al. Rev. Sci. Instrum., 1985; 56 (2): 201